Seat No. _____ Enrolment No.: _____

Gujarat Technological University

Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination

Subject Code: C322401 **Date:14-06-2017**

Subject Name: BASIC ELECTRONIC CIRCUITS

Time: 10.30AM TO 12.00PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

No.	Question Text and Option. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.			
1.	A semiconductor is formed by ..... bonds			
	A.	covalent	B.	electrovalent
	C.	co-ordinate	D.	none of the above
૧.	સેમીકંડક્ટર ..... બોંડ થી બને છે.			
	A.	કોવેલ્ન્ટ	B.	ઈલેક્ટ્રોવેલંટ
	C.	કો-ઓર્ડીનેટ	D.	આમા થી એક પણ નહીં.
2.	Semiconductor has ..... temperature coefficient of resistance.			
	A.	positive	B.	zero
	C.	negative	D.	none of the above
૨.	સેમીકંડક્ટર માં અવરોધ નો .....તાપમાન કો-એફિસિયંટ હોય.			
	A.	પોઝિટીવ	B.	ઝિરો
	C.	નેગેટીવ	D.	આમા થી એક પણ નહીં.
3.	The most commonly used semiconductor is			
	A.	germanium	B.	Silicon
	C.	carbon	D.	Sulphur
૩.	મોટા પ્રમાણ મા ઉપયોગ મા આવતો સેમીકંડકટર ..... છે.			
	A.	જર્મેનીયમ	B.	સિલીકોન
	C.	કાર્બન	D.	સલ્ફર
4.	A semiconductor has generally .....valence electrons.			
	A.	2	B.	3
	C.	6	D.	4
૪.	સેમીકંડક્ટેર માં મોટા ભાગે ..... વેલેંસ ઇલેક્ટ્રોન હોય.			
	A.	૨	B.	૩
	C.	૬	D.	૪
5.	The resistivity of pure silicon is about			
	A.	100 Ω cm	B.	6000 Ω cm
	C.	3×10^5 Ω cm	D.	1.6×10^8 Ω cm
૫.	શુધ્ધ સિલીકોન ની અવરોધકત્તા..... હોય.			
	A.	100 Ω cm	B.	6000 Ω cm
	C.	3×10^5 Ω cm	D.	1.6×10^8 Ω cm
6.	When a pure semiconductor is heated, its resistance			
	A.	goes up	B.	goes down
	C.	remains the same	D.	cannot say
૬.	જ્યારે શુધ્ધ સેમીકંડક્ટર ને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો અવરોધ.....			
	A.	અધે	B.	ઘટે

	C.	તેટલો જ રહે	D.	કહી ના શકાય.
7.	When a pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes			
	A.	an insulator	B.	an intrinsic semiconductor
	C.	*p*-type semiconductor	D.	*n*-type semiconductor
૭.	જ્યારે સેમીકંડક્ટર મા પેંટા વેલંટ અશુધ્ધી ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તે .....બને.			
	A.	ઇંસ્યુલેટર	B.	ઇંટ્રીંસીક સેમીકંડક્ટર
	C.	પી ટાઇપ સેમીકંડક્ટર	D.	એન ટાઇપ સેમીકંડક્ટર
8.	A pentavalent impurity has ..... valence electrons.			
	A.	3	B.	5
	C.	4	D.	6
૮.	પેંટાવેલંટ ઇમ્પ્યુરીટી માં ..... વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય.			
	A.	૩	B.	૫
	C.	૪	D.	૬
9.	A trivalent impurity has ..... valence electrons.			
	A.	4	B.	5
	C.	6	D.	3
૯.	ટ્રાઇવેલંટ ઇમ્પ્યુરીટી માં ..... વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય.			
	A.	૪	B.	૫
	C.	૬	D.	૩
10.	Addition of trivalent impurity to a semiconductor creates many			
	A.	holes	B.	free electrons
	C.	valence electrons	D.	bound electrons
૧૦.	સેમીકંડક્ટર માં ટ્રાઇ વેલંટ અશુધ્ધી ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તેમાં .....બને.			
	A.	હોલ	B.	ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન
	C.	વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન	D.	ઇલેક્ટ્રોન બોંડ
11.	A hole in a semiconductor is defined as			
	A.	a free electron	B.	the incomplete part of an electron pair bond
	C.	a free proton	D.	a free neutron
૧૧.	સેમીકંડક્ટર માં હોલ ને ..... વ્યાખ્યાયિત કરાય.			
	A.	ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન	B.	ઇલેક્ટ્રોન જોડી નો અધુરો ભાગ
	C.	ફ્રી પ્રોટ્રોન	D.	ફ્રી ન્યુટ્રોન
12.	In a semiconductor, current conduction is due			
	A.	only to holes	B.	only to free electrons
	C.	to holes and free electrons	D.	none of the above
૧૨.	સેમીકંડક્ટર માં કરંટ નુ વહન.....ના કારણે થાય.			
	A.	હોલ્સ	B.	ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન
	C.	હોલ્સ અને ફ્રી ઇલેક્ટ્રોંસ	D.	આમંથી એક પણ નહીં.
13.	A forward biased *pn* junction has a resistance of the			
	A.	order of Ω	B.	order of k Ω
	C.	order of M Ω	D.	none of the above
૧૩.	ફોરવર્ડ બાયસ પીએન જંક્શન માં તેનો અવરોધ ..... હોય.			
	A.	Ω માં	B.	k Ω માં
	C.	M Ω માં	D.	આમંથી એક પણ નહીં.
14.	The barrier voltage at a *pn* junction for germanium is about			
	A.	3.5 V	B.	3V
	C.	zero	D.	0.3 V
૧૪.	જર્મેનીયમ ના પીએન જંક્શન નો બેરીયર વોલ્ટેજ .....હોય.			
	A.	3.5 V	B.	3V
	C.	ઝિરો	D.	0.3 V

15.	The leakage current across a *pn* junction is due to			
	A.	minority carriers	B.	majority carriers
	C.	junction capacitance	D.	none of the above
૧૫.	પીએન જંક્શન માં લીકેજ કરંટ ..... ના કારણે હોય.			
	A.	માયનોરીટી કેરીયર	B.	મેજોરીટી કેરીયર
	C.	જંક્શન કેપેસીટંસ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
16.	With forward bias to a *pn* junction, the width of depletion layer			
	A.	decreases	B.	increases
	C.	remains the same	D.	none of the above
૧૬.	જ્યારે પીએન જંક્શન ને ફોરવર્ડ બાયસ કરવામાં આવે તો તેની ડેપ્લેશન લેયર ની પહોળાઇ...			
	A.	ઘટે	B.	વધે
	C.	સરખી જ રહે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
17.	A diode has			
	A.	one *pn* junction	B.	two *pn* junctions
	C.	three *pn* junctions	D.	none of the above
૧૭.	ડાયોડ ને .....જંક્શન હોય.			
	A.	એક પીએન	B.	બે પીએન
	C.	ત્રણ પીએન	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
18.	The forward voltage drop across a silicon diode is about			
	A.	2.5 V	B.	3 V
	C.	10 V	D.	0.7 V
૧૮.	સિલીકોન નો ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ ડ્રોપ .... હોય			
	A.	2.5 V	B.	3 V
	C.	10 V	D.	0.7 V
19.	An ideal diode is one which behaves as a perfect ..... when forward biased.			
	A.	conductor	B.	insulator
	C.	resistance material	D.	none of the above
૧૯.	એક આદર્શ ડાયોડ જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસ હોય ત્યારે....તરીકે વર્તે.			
	A.	કંડક્ટર	B.	ઇંશ્યુલેટર
	C.	અવરોધક	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
20.	If the temperature of a diode increases, then leakage current			
	A.	remains the same	B.	decreases
	C.	increases	D.	becomes zero
૨૦.	જો ડાયોડ નુ ત્તાપમાન વધે તો તેનો લીકેજ કરંટ.....			
	A.	સરખો જ રહે	B.	ઘટે
	C.	વધે	D.	શુન્ય થાય
21.	The knee voltage of a diode is approximately equal to			
	A.	applied voltage	B.	breakdown voltage
	C.	forward voltage	D.	barrier potential
૨૧.	ડાયોડ ના ની વોલ્ટેજ અંદાજીત.....જેટલો હોય.			
	A.	આપેલા વોલ્ટેજ	B.	બેક ડાઉન વોલ્ટેજ
	C.	ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ	D.	બેરીયર વોલ્ટેજ
22.	A zener diode has			
	A.	one *pn* junction	B.	two *pn* junctions
	C.	three *pn* junctions	D.	none of the above
૨૨.	ઝેનર ડાયોડ ને .....જંક્શન હોય.			
	A.	એક પીએન	B.	બે પીએન
	C.	ત્રણ પીએન	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
23.	A zener diode is used as			
	A.	an amplifier	B.	a voltage regulator

	C.	a rectifier	D.	a multi-vibrator
૨૩.	ઝેનર ડાયોડ નો ઉપયોગ .....તરીકે થાય.			
	A.	એમ્પ્લીફાયર	B.	વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર
	C.	રેકટીફાયર	D.	મ્લ્ટી વાઇબ્રેટર
24.	A zener diode is always ..... connected.			
	A.	reverse	B.	forward
	C.	either reverse or forward	D.	none of the above
૨૪.	ઝેનર ડાયોડ હમેશા .....મા જોડાય			
	A.	રિવર્સ	B.	ફોરવર્ડ
	C.	રિવર્સ અથવા ફોરવર્ડ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
25.	zener diode utilizes ..... characteristic for its operation.			
	A.	forward	B.	reverse
	C.	both forward and reverse	D.	none of the above
૨૫.	ઝેનર ડાયોડ તેના કાર્ય માટે .....સંરચના નો ઉપયોગ કરે.			
	A.	ફોરવર્ડ બાયસ	B.	રિવર્સ બાયસ
	C.	રિવર્સ અને ફોરવર્ડ બન્ને	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
26.	In the breakdown region, a zener diode behaves like a ..... source.			
	A.	constant voltage	B.	constant current
	C.	constant resistance	D.	none of the above
૨૬.	બ્રેકડાઉન રીજીયન માં ઝેનર ડાયોડ .....સોર્સ તરીકે વર્તે.			
	A.	કોંસ્ટંટ વોલ્ટેજ	B.	કોંસ્ટંટ કરંટ
	C.	કોંસ્ટંટ અવરોધ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
27.	A zener diode is destroyed if it			
	A.	is forward biased	B.	is reverse biased
	C.	carries more than rated current	D.	none of the above
૨૭.	ઝેનર ડાયોડ નાશ પમે જ્યારે તે.....			
	A.	ફોરવર્ડ બાયસ હોય	B.	રીવર્સ બાયસ હોય
	C.	ક્ષમતા કરતા વધુ કરંટ લે ત્યારે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
28.	The disadvantage of a half-wave rectifier is that the			
	A.	components are expensive	B.	diodes must have a higher power rating
	C.	output is difficult to filter	D.	none of the above
૨૮.	હાફ વેવ રેકટીફાયર નો ગેર ફાયદો એ.....છે.			
	A.	કમ્પોનેંટ મોંઘા	B.	ડાયોડ નુ પાવર રેટીંગ વધુ હોવુ જોઇએ.
	C.	આઉટપુટ ને ફિલ્ટર કરવુ અઘરુ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
29.	The ripple factor of a half-wave rectifier is			
	A.	2	B.	1.21
	C.	2.5	D.	0.48
૨૯.	હાફ વેવ રેકટીફાયર નો રીપલ ફેકટર .....હોય			
	A.	2	B.	1.21
	C.	2.5	D.	0.48
30.	There is a need of transformer for			
	A.	half-wave rectifier	B.	centre-tap full-wave rectifier
	C.	bridge full-wave rectifier	D.	none of the above
૩૦.	ટ્રાંસ્ફોર્મર ની જરુર .....માં પડે.			
	A.	હાફ વેવ રેકટીફાયર	B.	સેંટર ટેપ ફુલ વેવ રેકટીફાયર
	C.	બ્રિજ ફુલ વેવ રેકટીફાયર	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
31.	The *PIV* rating of each diode in a bridge rectifier is ..... that of the equivalent center-tap rectifier.			
	A.	one-half	B.	the same as
	C.	twice	D.	four times

૩૧.	બ્રિજ રેક્ટીફાયર ના દરેક ડાયોડ નુ PIV રેટીંગ એ તેને સમકક્ષ સેંટર ટેપ રેક્ટીફાયર ના..... જેટલુ હોય.			
	A.	અડધા	B.	સરખુ
	C.	બમણુ	D.	ચાર ગણુ
32.	If the PIV rating of a diode is exceeded, ...			
	A.	the diode conducts poorly	B.	the diode is destroyed
	C.	the diode behaves as zener diode	D.	none of the above
૩૨.	જો ડાયોડ નુ PIV રેટીંગ વધી જાય તો,.....			
	A.	ડાયોડ મંદ પ્રવાહ વહન કરે	B.	ડાયોડ નાશ પામે
	C.	ઝેનર ડાયોડ તરીકે વર્તે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
33.	The maximum efficiency of a half-wave rectifier is			
	A.	40.6%	B.	81.2%
	C.	50%	D.	25%
૩૩.	હાલ્ફ વેવ રેક્ટીફાયર ની મહતમ કાર્યક્ષમતા.....હોય.			
	A.	40.6%	B.	81.2%
	C.	50%	D.	25%
34.	A *pn* junction that radiates energy as light instead of as heat is called a			
	A.	LED	B.	photo-diode
	C.	photocell	D.	Zener diode
૩૪.	એવુ પીએન જંક્શન કે જે પ્રકાશ ઉત્સર્જીત કરે ઉશ્મા ને બદલે તેને.....કહેવાય			
	A.	LED	B.	ફોટો ડાયોડ
	C.	ફોટો સેલ	D.	ઝેનર ડાયોડ
35.	The capacitance of a varactor diode increases when reverse voltage across it			
	A.	decreases	B.	increases
	C.	breaks down	D.	stores charge
૩૫.	વેરેક્ટર ડાયોડ નો કેપેસીટંસ વધે કે જ્યારે તેના રીવર્સ વોલ્ટેજ.....			
	A.	ઘટે	B.	વધે
	C.	બ્રેક ડાઉન	D.	ચાર્જ સ્ટોર થાય
36.	To display the digit 8 in a seven-segment indicator			
	A.	C must be lighted	B.	G must be off
	C.	F must be on	D.	All segments must be lighted
૩૬.	સેવન સેજમેટ ડિસ્પ્લે માં આઠ પ્રકાશિત કરવા માટે.....			
	A.	C પ્રકાશિત હોવો જોઇએ	B.	G બંધ હોવો જોઇએ
	C.	F ચાલુ હોવો જોઇએ	D.	બધા જ ભાગ પ્રકાશિત હોવા જોઇએ.
37.	A photo-diode is normally			
	A.	forward-biased	B.	reverse-biased
	C.	Neither forward nor reverse biased	D.	Emitting light
૩૭.	સામાન્ય પણે ફોટો ડાયોડ .....હોય			
	A.	ફોરવર્ડ બાયસ	B.	રિવર્સ બાયસ
	C.	રિવર્સ અને ફોરવર્ડ બન્ને નહીં	D.	પ્રકાશિત હોય.
38.	The device associated with voltage-controlled capacitance is a			
	A.	LED	B.	photo-diode
	C.	varactor diode	D.	Zener diode
૩૮.	વોલ્ટેજ કંટ્રોલ્ડ કેપેસીટંસ સાથે સંકળાયેલ ડિવાઇસ નુ નામ .....છે.			
	A.	એલઇડી	B.	ફોટો ડાયોડ
	C.	વેરેક્ટર ડાયોડ	D.	ઝેનર ડાયોડ
39.	When the light increases, the reverse current in a photo-diode			
	A.	increases	B.	decreases
	C.	is unaffected	D.	none of the above

૩૯.	જ્યારે પ્રકાશ વધે ત્યારે ફોટો ડાયોડ નો રિવર્સ કરન્ટ			
	A.	વધે	B.	ઘટે
	C.	ના બદલાય	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
40.	To display the digit 0 in a seven segment-display			
	A.	A must be lighted	B.	F must be off
	C.	G must be on	D.	all segments except G should be lighted
૪૦.	સેવન સેજમેટ ડિસ્પ્લે માં શુન્ય પ્રકાશિત કરવા માટે.....			
	A.	A પ્રકાશિત હોવો જોઇએ	B.	F બંધ હોવો જોઇએ.
	C.	G ચાલુ હોવો જોઇએ	D.	G સિવાય બધા પ્રકાશિત હોવા જોઇએ.
41.	A single stage transistor amplifier contains ..... and associated circuitry.			
	A.	two transistors	B.	one transistor
	C.	three transistors	D.	none of the above
૪૧.	સિગલ ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર માં.....અને તેને સંલગ્ન સરકીટ હોય.			
	A.	બે ટ્રાંઝિસ્ટર	B.	એક ટ્રાંઝિસ્ટર
	C.	ત્રણ ટ્રાંઝિસ્ટર	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
42.	The phase difference between the output and input voltages of a *CE* amplifier is			
	A.	180º	B.	0º
	C.	90º	D.	270º
૪૨.	સીઇ એમ્પ્લીફાયર ના ઇનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ નો ફેઇઝ તફાવત.....હોય.			
	A.	180º	B.	0º
	C.	90º	D.	270º
43.	It is generally desired that a transistor should have ..... input impedance.			
	A.	low	B.	very low
	C.	high	D.	very high
૪૩.	સામાન્યપણે ટ્રાંઝિસ્ટર માં .....ઇનપુટ ઇમ્પીડંસ હોય.			
	A.	ઓછો	B.	ઘણો ઓછો
	C.	વધુ	D.	ઘણો વધુ
44.	When an a.c. signal is applied to an amplifier, the operating point moves along			
	A.	d.c. load line	B.	a.c. load line
	C.	both d.c. and a.c. load lines	D.	none of the above
૪૪.	જ્યારે એસી સિગ્નલ એમ્પ્લીફાયર ને આપવામાં આવે ત્યારે ઓપરેટીંગ પોઇંટ...તરફ જાય.			
	A.	ડીસી લોડ લાઇન	B.	એસી લોડ લાઇન
	C.	ડીસી અને એસી લોડ લાઇન બન્ને	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
45.	In the zero signal conditions, a transistor sees ..... load.			
	A.	d.c.	B.	a.c.
	C.	both d.c. and a.c	D.	none of the above
૪૫.	ઝિરો સિગ્નલ કન્ડીશન માં ટ્રાંઝિસ્ટર ને .....લોડ હોય.			
	A.	ડીસી	B.	એસી
	C.	ડીસી અને એસી બન્ને	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
46.	The point of intersection of d.c. and a.c. load lines is called			
	A.	saturation point	B.	cut off point
	C.	operating point	D.	none of the above
૪૬.	ડીસી અને એસી લોસ લાઇન નો ઇંટરસેક્શન ..... કહેવાય.			
	A.	સેચ્યુરેશન પોઇંટ	B.	કટ-ઓફ પોઇંટ
	C.	ઓપરેટીંગ પોઇંટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
47.	The purpose of capacitors in a transistor amplifier is to			
	A.	protect the transistor	B.	cool the transistor
	C.	couple or bypass a.c. component	D.	provide biasing
૪૭.	ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર માં કેપેસીટર નુ કારણ .....નુ છે.			
	A.	ટ્રાંઝિસ્ટર ને પ્રોટેક્શન	B.	ટ્રાંઝિસ્ટર ને ઠંડો રાખવા

	C.	એસી ને કપલ કે બાયપાસ કરવા	D.	બાયસીંગ આપવા
48.	In practice, the voltage gain of an amplifier is expressed			
	A.	as volts	B.	as a number
	C.	in *db*	D.	none of the above
૪૮.	સામાન્ય પણે એમ્પ્લીફાયર નો વોલ્ટેજ ગેઇન .....માં હોય.			
	A.	વોલ્ટ	B.	નંબર
	C.	ડીબી	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
49.	If the power and current gains of a transistor amplifier are 16500 and 100 respectively, then voltage gain is			
	A.	165	B.	165×10^4
	C.	100	D.	none of the above
૪૯.	જો ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર ના પાવર અને કરંટ ગેઇન ૧૬૫૦૦ અને ૧૦૦ હોય તો, વોલ્ટેજ ગેઇન ....થાય.			
	A.	165	B.	165×10^4
	C.	100	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
50.	In a *CE* amplifier, the phase difference between voltage across collector load *RC* and signal voltage is			
	A.	180º	B.	270º
	C.	90º	D.	0º
૫૦.	*CE* એમ્પ્લીફાયર માં કલેક્ટર લોડ *RC* અને સિગ્નલ વોલ્ટેજ વચ્ચેનો ફેઝ તફાવત.... હોય.			
	A.	180º	B.	270º
	C.	90º	D.	0º
51.	The purpose of d.c. conditions in a transistor is to			
	A.	reverse bias the emitter	B.	forward bias the collector
	C.	set up operating point	D.	none of the above
૫૧.	ટ્રાંઝિસ્ટર માં ડીસી કંડીશન નુ કારણ .....કરવાનુ.			
	A.	એમીટર ને રીવર્સ બાયસ	B.	કલેક્ટર ને ફોરવર્ડ બાયસ કરવાનું
	C.	ઓપરેટીંગ પોઇંટ સેટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
52.	The ratio of output to input impedance of a *CE* amplifier is			
	A.	about 1	B.	low
	C.	high	D.	moderate
૫૨.	CE એમ્પ્લીફાયર ના આઉટપુટ થી ઇનપુટ ઇમ્પીડંસ નો રેશીયો.....હોય.			
	A.	૧ જેટલો	B.	ઓછો
	C.	વધુ	D.	મધ્યમ
53.	The output power of a transistor amplifier is more than the input power because the additional power is supplied by			
	A.	transistor	B.	biasing circuit
	C.	collector supply *VCC*	D.	none of the above
૫૩.	ટ્રાંઝિસ્ટર એમ્પલીફાયર નો આઉટપુટ પાવર ઇનપુટ પાવર કરતા વધારે હોય છે કારણ કે વધારાનો પાવર ..... દ્વારા મળે છે.			
	A.	ટ્રાંઝિસ્ટર	B.	બાયસીગ સરકીટ
	C.	કલેક્ટર સપ્લાય *VCC*	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
54.	A transistor converts			
	A.	d.c. power into a.c. power	B.	a.c. power into d.c. power
	C.	high resistance into low resistance	D.	none of the above
૫૪.	ટ્રાંઝિસ્ટર .....માં બદલે.			
	A.	ડીસી પાવર ને એસી પાવર	B.	એસી પાવર ને ડીસી પાવર
	C.	વધુ અવરોધ માંથી ઓછા અવરોધ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
55.	For highest power gain, one would use ..... configuration.			
	A.	*CC*	B.	*CB*
	C.	*CE*	D.	none of the above

૫૫.	વધુ પાવર ગેઇન માટે .....સંરચના વાપરવી જોઇએ.			
	A.	*CC*	B.	*CB*
	C.	*CE*	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
56.	*CC* configuration is used for impedance matching because its			
	A.	input impedance is very high	B.	input impedance is low
	C.	output impedance is very low	D.	none of the above
૫૬.	*CC* સંરચના ઇમ્પીડેન્સ મેચીંગ માટે વપરાય છે કારણ કે તેનો.....			
	A.	ઇનપુટ ઇમ્પીડંસ ઘણો વધુ હોય	B.	ઇનપુટ ઇમ્પીડંસ ઓછો હોય
	C.	આઉટપુટ ઇમ્પીડંસ ઘણો ઓછો	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
57.	When negative voltage feedback is applied to an amplifier, its voltage gain			
	A.	is increased	B.	is reduced
	C.	remains the same	D.	none of the above
૫૭.	એમ્પ્લીફાયર માં જ્યારે નેગેટીવ ફીડબેક આપીએ તો તેનો વોલ્ટેજ ગેઇન.....			
	A.	વધે	B.	ઘટે
	C.	ના બદલાય	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
58.	In an unregulated power supply, if load current increases, the output voltage			
	A.	remains the same	B.	decreases
	C.	increases	D.	none of the above
૫૮.	અનરેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાય માં જો લોડ કરંટ વધે તો આઉટપુટ વોલ્ટેજ.....			
	A.	સરખોજ રહે	B.	ઘટે
	C.	વધે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
59.	In an unregulated power supply, if input a.c. voltage increases, the output voltage			
	A.	increases	B.	decreases
	C.	remains the same	D.	none of the above
૫૯.				
	A.		B.	
	C.		D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
60.	A zener diode is used as a ..... voltage regulating device.			
	A.	shunt	B.	series
	C.	series-shunt	D.	none of the above
૬૦.	ઝેનર ડાયોડ..... વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટીંગ ડિવાઇસ તરીકે વપરાય.			
	A.	શંટ	B.	સિરિઝ
	C.	સિરિઝ-શંટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
61.	As the junction temperature increases, the voltage breakdown point for zener mechanism.....			
	A.	is increased	B.	is decreased
	C.	remains the same	D.	none of the above
૬૧.	જો જંક્શન તાપમાન વધે તો, ઝેનર માટે નો બ્રેકડાઉન પોઇન્ટ....			
	A.	વધે	B.	ઘટે
	C.	ના બદલાય	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
62.	Thermal runaway occurs when			
	A.	collector is reverse biased	B.	transistor is not biased
	C.	emitter is forward biased	D.	junction capacitance is high
૬૨.	થર્મલ રન-અવે થાય જ્યારે			
	A.	કલેક્ટર રિવર્સ બાયસ હોય	B.	ટ્રાન્ઝિસ્ટર બાયસ માં ના હોય
	C.	એમીટર ફોરવર્ડ બાયસ હોય	D.	જંક્શન કેપેસીટંસ વધુ હોય
63.	As the junction temperature increases, the voltage breakdown point for avalanche mechanism			
	A.	remains the same	B.	decreases
	C.	increases	D.	none of the above
	જો જંક્શન તાપમાન વધે તો, એવેલાંચ મિકેનિઝમ માટે નો બ્રેકડાઉન પોઇન્ટ....			

૬૩.	A.	સરખો જ રહે	B.	ઘટે
	C.	વધે	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
64.	Zener diodes are generally made of			
	A.	germanium	B.	silicon
	C.	carbon	D.	none of the above
૬૪.	ઝેનર ડાયોડ ને સામાન્ય પણે ..... માંથી બનાવવામા આવે છે.			
	A.	જર્મેનીયમ	B.	સિલીકોન
	C.	કાર્બન	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
65.	For increasing the voltage rating, zeners are connected in.....			
	A.	parallel	B.	series-parallel
	C.	series	D.	none of the above
૬૫.	વોલ્ટેજ રેટીંગ વધારવા માટે ઝેનર ને ..... માં જોડવા જોઇએ.			
	A.	સમાંતર	B.	સિધા- સમાંતર
	C.	સિધા	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
66.	For faithful amplification by a transistor circuit, the value of VCE should ..... for silicon transistor.			
	A.	not fall below 1 V	B.	be zero
	C.	be 0.2 V	D.	none of the above
૬૬.	ટ્રાંઝિસ્ટર સરકીટ ના યોગ્ય એમ્પ્લીફીકેશન માટે ,સિલિકોન ટ્રાંઝિસ્ટૅર મા VCE ની કિંમત....હોય.			
	A.	૧ વોલ્ટ થી ઓછી નહીં	B.	શુન્ય
	C.	૦.૨ વોલ્ટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
67.	An ideal value of stability factor is			
	A.	100	B.	200
	C.	more than 200	D.	1
૬૭.	સ્ટેબીલીટી ફેક્ટર ની આદર્શ કિંમત ..... હોય			
	A.	૧૦૦	B.	૨૦૦
	C.	૨૦૦ કરત્તા વધુ	D.	૧
68.	The operating point in transistor is also called the			
	A.	cut off point	B.	quiescent point
	C.	saturation point	D.	none of the above
૬૮.	ટ્રાંઝિસ્ટર ઓપરેટીંગ પોઇંટ ને..... પણ કહેવાય.			
	A.	કટ ઓફ પોઇંટ	B.	ક્વિશંટ પોઇંટ
	C.	સેચ્યુરેશન પોઇંટ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
69.	For proper amplification by a transistor circuit, the operating point should be located at ..... of the D.C. load line.			
	A.	the end point	B.	middle
	C.	the maximum current point	D.	none of the above
૬૯.	ટ્રાંઝિસ્ટર સરકીટ ના યોગ્ય એમ્પ્લીફીકેશન માટે , ઓપરેટીંગ પોઇંટ ને ડી.સી. લોડ લાઇન માં ..... પર હોવો જોઇએ.			
	A.	અંત	B.	મધ્યમા
	C.	મહત્તમ કરંટ જગ્યા પર	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.
70.	The disadvantage of voltage divider bias is that it has			
	A.	high stability factor	B.	low base current
	C.	many resistors	D.	none of the above
૭૦.	વોલ્ટેજ ડિવાઇડર બાયસ નો ગેરફાયદો એ તેને.....છે.			
	A.	વધુ સ્ટેબીલીટી ફેક્ટર	B.	ઓછો બેઝ કરંટ
	C.	ઘણા અવરોધ	D.	આમાંથી એક પણ નહીં.

****